



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

DSK12W-DSK120W

SOD-123FL Schottky Barrier Rectifier Diode 肖特基势垒整流二极管

■ Features 特点

Low forward voltage drop 低正向压降
 High current capability 高电流能力
 Surface mount device 表面贴装器件
 Case 封装:SOD-123FL



■ Maximum Rating 最大额定值

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

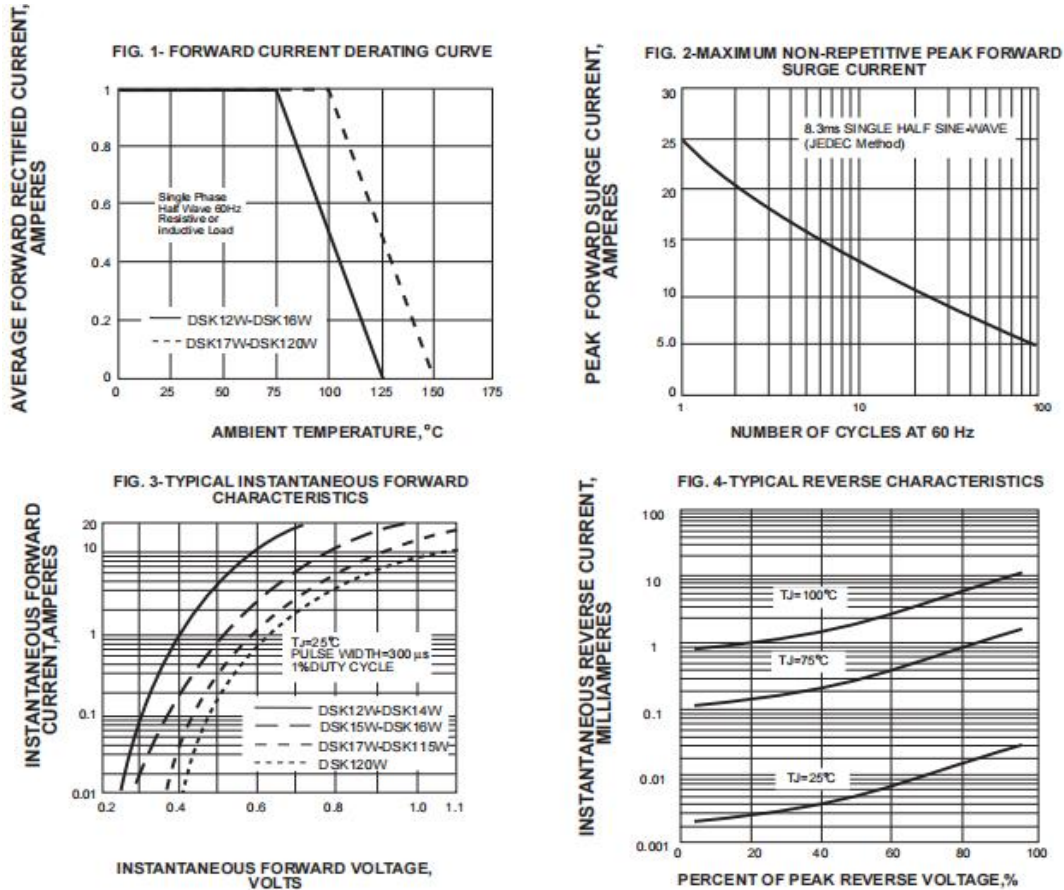
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	DSK 12W	DSK 13W	DSK 14W	DSK 15W	DSK 16W	DSK 17W	DSK 18W	DSK 19W	DSK 110W	DSK 115W	DSK 120W	Unit 单位
Peak Reverse Voltage 反向峰值电压	V_{RRM}	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	V
DC Reverse Voltage 直流反向电压	V_R	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	V
RMS Reverse Voltage 反向电压均方根值	$V_{R(RMS)}$	14	21	28	35	42	49	56	63	70	105	140	V
Forward Rectified Current 正向整流电流	I_F	1											A
Peak Surge Current 峰值浪涌电流	I_{FSM}	25											A
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	125											$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Junction/Storage Temperature 结温/储藏温度	T_J, T_{stg}	-50to+150 $^{\circ}\text{C}$											$^{\circ}\text{C}$

■ Electrical Characteristics 电特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	DSK12W- DSK14W	DSK15W- DSK16W	DSK17W- DSK115W	DSK 120W	Unit 单位	Condition 条件
Forward Voltage 正向电压	V_F	0.55	0.70	0.85	0.95	V	$I_F=1\text{A}$
Reverse Current 反向电流	$I_R(25^{\circ}\text{C})$ (100°C)	0.5 10		0.5 5	0.2 2	mA	$V_R=V_{RRM}$
Diode Capacitance 二极管电容	C_D	110		80		pF	$V_R=4\text{V}$, $f=1\text{MHz}$

Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



SOD-123FL Dimension 外形封装尺寸 Unit in millimeters 单位: 毫米

